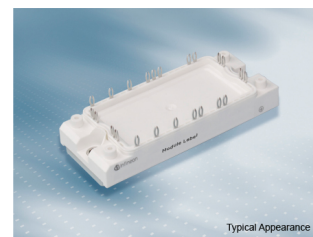


EconoPIM™2 モジュール with TRENCHSTOP™ IGBT7 and emitter controlled 7 diode と PressFIT / NTC サーミスタ / TIM

特徴

- 電気的特性
 - $V_{CES} = 1200\text{ V}$
 - $I_{C\text{ nom}} = 50\text{ A} / I_{CRM} = 100\text{ A}$
 - トレンチ IGBT 7
 - 低 V_{CESat} 飽和電圧
 - 最大 175°C の過負荷動作
- 機械的特性
 - 高いパワー/サーマルサイクル耐量
 - 内蔵された NTC サーミスタ
 - 銅ベースプレート
 - 低熱インピーダンスの Al_2O_3 DCB
 - PressFIT 接合 技術
 - 予め塗布されたサーマルインターフェース材料



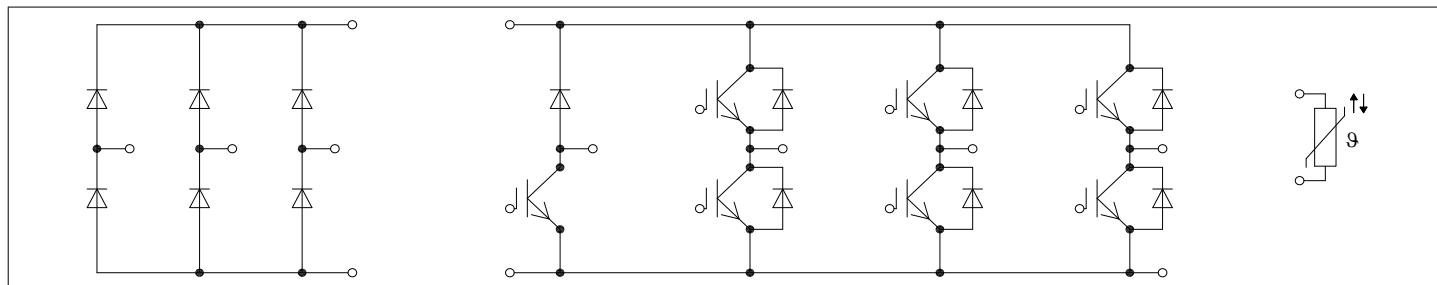
可能性のある用途

- 補助インバーター
- モーター駆動
- サーボ駆動

製品検証

- IEC 60747、60749、および 60068 の関連試験に準拠して産業用アプリケーションに適合

詳細



目次

	詳細	1
	特徴	1
	可能性のある用途	1
	製品検証	1
	目次	2
1	ハウジング	3
2	IGBT- インバータ	3
3	Diode、インバータ	5
4	Diode、整流器	6
5	IGBT、チョツパー	6
6	Diode-、チョツパー	8
7	NTC-サーミスタ	9
8	特性図	10
9	回路図	16
10	パッケージ外形図	17
	改訂履歴	18
	Disclaimer	19

1 ハウジング

1 ハウジング

表 1 絶縁協調

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
絶縁耐圧	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$	2.5	kV
ベースプレート材質			Cu	
内部絶縁		基礎絶縁 (クラス 1, IEC 61140)	Al_2O_3	
沿面距離	d_{Creep}	連絡方法 - ヒートシンク	10.0	mm
空間距離	d_{Clear}	連絡方法 - ヒートシンク	7.5	mm
相対トラッキング指数	CTI		> 200	
相対温度指数 (電気)	RTI	住宅	140	°C

表 2 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
内部インダクタンス	L_{SCE}			35		nH
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{AA'+CC'}$	$T_H = 25^\circ\text{C}$, /スイッチ		5.5		mΩ
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{CC'+EE'}$	$T_H = 25^\circ\text{C}$, /スイッチ		4.8		mΩ
保存温度	T_{stg}		-40		125	°C
最大ベース・プレート動作温度	T_{BPmax}				125	°C
取り付けネジ締め付けトルク	M	適切なアプリケーションノートによるマウンティング	M5, 取り付けネジ	3	6	Nm
質量	G			180		g

注: The current under continuous operation is limited to 50 A rms per connector pin.
Storage and shipment of modules with TIM => see AN2012-07

2 IGBT- インバータ

表 3 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CES}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1200	V
連続 DC コレクタ電流	I_{CDC}	$T_{vj \max} = 175^\circ\text{C}$, $T_H = 95^\circ\text{C}$	50	A
繰り返しピークコレクタ電流	I_{CRM}	$t_P = 1 \text{ ms}$	100	A
ゲート・エミッタ間ピーク電圧	V_{GES}		±20	V

表 4 電気的特性

項目	記号	条件及び注記		規格値			単位
				最小	標準	最大	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 50\ A, V_{GE} = 15\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		1.50	1.80	V
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		1.64		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		1.72		
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	V_{GEth}	$I_C = 2\ mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\ ^\circ C$		5.15	5.80	6.45	V
ゲート電荷量	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\ V, V_{CE} = 600\ V$			0.92		μC
内蔵ゲート抵抗	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			0		Ω
入力容量	C_{ies}	$f = 1000\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			11.1		nF
帰還容量	C_{res}	$f = 1000\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			0.039		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流	I_{CES}	$V_{CE} = 1200\ V, V_{GE} = 0\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			0.01	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流	I_{GES}	$V_{CE} = 0\ V, V_{GE} = 20\ V, T_{vj} = 25\ ^\circ C$				100	nA
ターンオン遅延時間(誘導負荷)	t_{don}	$I_C = 50\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 7.5\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.059		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.061		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.062		
ターンオン上昇時間(誘導負荷)	t_r	$I_C = 50\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 7.5\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.043		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.047		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.049		
ターンオフ遅延時間(誘導負荷)	t_{doff}	$I_C = 50\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 7.5\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.290		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.380		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.420		
ターンオフ下降時間(誘導負荷)	t_f	$I_C = 50\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 7.5\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.110		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.200		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.270		
ターンオンスイッチング損失	E_{on}	$I_C = 50\ A, V_{CE} = 600\ V, L_\sigma = 35\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 7.5\ \Omega, di/dt = 900\ A/\mu s (T_{vj} = 175\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		5.07		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		6.76		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		7.72		
ターンオフスイッチング損失	E_{off}	$I_C = 50\ A, V_{CE} = 600\ V, L_\sigma = 35\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 7.5\ \Omega, dv/dt = 2900\ V/\mu s (T_{vj} = 175\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		3.37		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		5.31		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		6.58		
短絡電流	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15\ V, V_{CC} = 800\ V, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_P \leq 8\ \mu s, T_{vj} = 150\ ^\circ C$		190		A
			$t_P \leq 7\ \mu s, T_{vj} = 175\ ^\circ C$		180		

表 4 電気的特性 (continued)

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	IGBT 部 (1 素子当り), Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			0.777	K/W
動作温度	$T_{vj\ op}$		-40		175	°C

注: $T_{vj\ op} > 150^{\circ}\text{C}$ is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

3 Diode、インバータ

表 5 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	1200	V
連続 DC 電流	I_F		50	A
ピーク繰返し順電流	I_{FRM}	$t_p = 1\ \text{ms}$	100	A
電流二乗時間積	I^2t	$V_R = 0\ \text{V}, t_p = 10\ \text{ms}$	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	A^2s
			$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	

表 6 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	V_F	$I_F = 50\ \text{A}, V_{GE} = 0\ \text{V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		1.72	V
			$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		1.59	
			$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$		1.52	
ピーク逆回復電流	I_{RM}	$I_F = 35\ \text{A}, V_R = 600\ \text{V}, V_{GE} = -15\ \text{V}, -di_F/dt = 900\ \text{A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175^{\circ}\text{C})$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		31	A
			$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		39	
			$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$		45	
逆回復電荷量	Q_r	$I_F = 50\ \text{A}, V_R = 600\ \text{V}, V_{GE} = -15\ \text{V}, -di_F/dt = 900\ \text{A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175^{\circ}\text{C})$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		3.96	μC
			$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		7.37	
			$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$		9.89	
逆回復損失	E_{rec}	$I_F = 50\ \text{A}, V_R = 600\ \text{V}, V_{GE} = -15\ \text{V}, -di_F/dt = 900\ \text{A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175^{\circ}\text{C})$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		1.31	mJ
			$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		2.52	
			$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$		3.46	
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	/Diode (1 素子当り), Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			1.13	K/W
動作温度	$T_{vj\ op}$		-40		175	°C

4 Diode、整流器

注: $T_{vj, op} > 150^{\circ}\text{C}$ is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

4 Diode、整流器

表 7 最大定格

項目	記号	条件及び注記		定格値	単位
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		1600	V
最大実効順電流/chip	I_{FRMSM}	$T_H = 60^{\circ}\text{C}$		70	A
整流出力の最大実効電流	I_{RMSM}	$T_H = 60^{\circ}\text{C}$		100	A
サージ順電流	I_{FSM}	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	560	A
			$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	435	
電流二乗時間積	I^2t	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	1570	A^2s
			$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	945	

表 8 電気的特性

項目	記号	条件及び注記		規格値			単位
				最小	標準	最大	
順電圧	V_F	$I_F = 50\text{ A}$	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		1.05		V
逆電流	I_r	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$, $V_R = 1600\text{ V}$			1		mA
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	/Diode (1 素子当り), Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material				1.10	K/W
動作温度	$T_{vj, op}$			-40		150	$^{\circ}\text{C}$

5 IGBT、チョツパー

表 9 最大定格

項目	記号	条件及び注記		定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CES}		$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	1200	V
連続 DC コレクタ電流	I_{CDC}	$T_{vj, max} = 175^{\circ}\text{C}$	$T_H = 110^{\circ}\text{C}$	25	A
繰返しピークコレクタ電流	I_{CRM}	$t_p = 1\text{ ms}$		50	A
ゲート・エミッタ間ピーク電圧	V_{GES}			± 20	V

表 10 電気的特性

項目	記号	条件及び注記		規格値			単位
				最小	標準	最大	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 25\ A, V_{GE} = 15\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		1.60	1.85	V
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		1.74		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		1.82		
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	V_{GEth}	$I_C = 0.525\ mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\ ^\circ C$		5.15	5.80	6.45	V
ゲート電荷量	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\ V, V_{CE} = 600\ V$			0.395		μC
内蔵ゲート抵抗	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			0		Ω
入力容量	C_{ies}	$f = 1000\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			4.77		nF
帰還容量	C_{res}	$f = 1000\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			0.017		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流	I_{CES}	$V_{CE} = 1200\ V, V_{GE} = 0\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			0.004	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流	I_{GES}	$V_{CE} = 0\ V, V_{GE} = 20\ V, T_{vj} = 25\ ^\circ C$				100	nA
ターンオン遅延時間(誘導負荷)	t_{don}	$I_C = 25\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 9.1\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.041		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.043		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.044		
ターンオン上昇時間(誘導負荷)	t_r	$I_C = 25\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 9.1\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.025		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.028		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.030		
ターンオフ遅延時間(誘導負荷)	t_{doff}	$I_C = 25\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 9.1\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.230		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.320		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.350		
ターンオフ下降時間(誘導負荷)	t_f	$I_C = 25\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 9.1\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.140		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.220		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.280		
ターンオンスイッチング損失	E_{on}	$I_C = 25\ A, V_{CE} = 600\ V, L_\sigma = 35\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 9.1\ \Omega, di/dt = 780\ A/\mu s (T_{vj} = 175\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		1.47		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		2.05		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		2.39		
ターンオフスイッチング損失	E_{off}	$I_C = 25\ A, V_{CE} = 600\ V, L_\sigma = 35\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 9.1\ \Omega, dv/dt = 3120\ V/\mu s (T_{vj} = 175\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		1.65		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		2.58		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		3.13		
短絡電流	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15\ V, V_{CC} = 800\ V, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_P \leq 8\ \mu s, T_{vj} = 150\ ^\circ C$		90		A
			$t_P \leq 7\ \mu s, T_{vj} = 175\ ^\circ C$		85		

表 10 電気的特性 (continued)

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	IGBT 部 (1 素子当り), Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			1.19	K/W
動作温度	$T_{vj\ op}$		-40		175	°C

注: $T_{vj\ op} > 150^{\circ}\text{C}$ is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

6 Diode-、チョツパー

表 11 最大定格

項目	記号	条件及び注記		定格値	単位
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}		$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	1200	V
連続 DC 電流	I_F			25	A
ピーク繰返し順電流	I_{FRM}	$t_P = 1\text{ ms}$		50	A
電流二乗時間積	I^2t	$V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	125	A^2s
			$T_{vj} = 175\text{ }^{\circ}\text{C}$	95	

表 12 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	V_F	$I_F = 25\ \text{A}, V_{GE} = 0\ \text{V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		1.83	V
			$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		1.70	
			$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$		1.63	
ピーク逆回復電流	I_{RM}	$I_F = 25\ \text{A}, V_R = 600\ \text{V}, V_{GE} = -15\ \text{V}, -di_F/dt = 395\ \text{A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175^{\circ}\text{C})$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		18	A
			$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		25	
			$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$		29	
逆回復電荷量	Q_r	$I_F = 25\ \text{A}, V_R = 600\ \text{V}, V_{GE} = -15\ \text{V}, -di_F/dt = 395\ \text{A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175^{\circ}\text{C})$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		2.79	μC
			$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		3.36	
			$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$		4.41	
逆回復損失	E_{rec}	$I_F = 25\ \text{A}, V_R = 600\ \text{V}, V_{GE} = -15\ \text{V}, -di_F/dt = 395\ \text{A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175^{\circ}\text{C})$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		1.36	mJ
			$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		1.54	
			$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$		2.03	
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	/Diode (1 素子当り), Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			1.63	K/W
動作温度	$T_{vj\ op}$		-40		175	°C

注: $T_{vj\ op} > 150^{\circ}\text{C}$ is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

7 NTC-サーミスタ

表 13 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
定格抵抗値	R_{25}	$T_{NTC} = 25^{\circ}\text{C}$		5		k Ω
R_{100} の偏差	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100^{\circ}\text{C}$, $R_{100} = 493\ \Omega$	-5		5	%
損失	P_{25}	$T_{NTC} = 25^{\circ}\text{C}$			20	mW
B-定数	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\ \text{K}))]$		3375		K
B-定数	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\ \text{K}))]$		3411		K
B-定数	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\ \text{K}))]$		3433		K

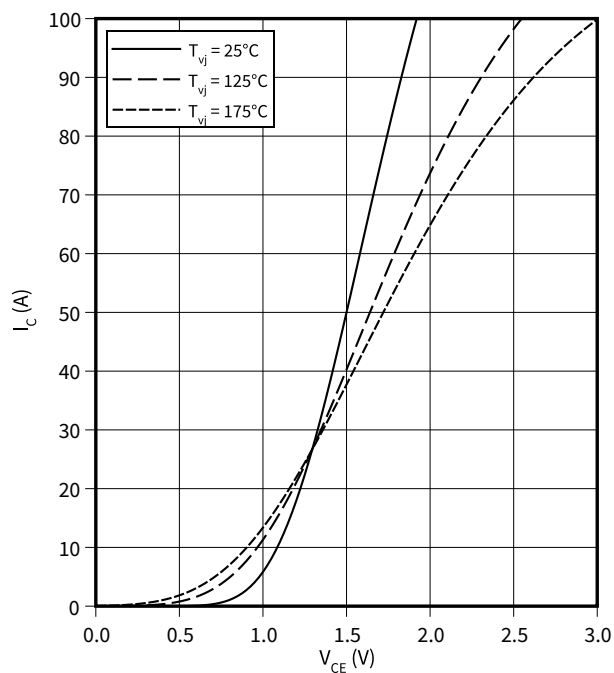
注: 適切なアプリケーションノートによる仕様

8 特性図

出力特性 (Typical), IGBT- インバータ

$$I_C = f(V_{CE})$$

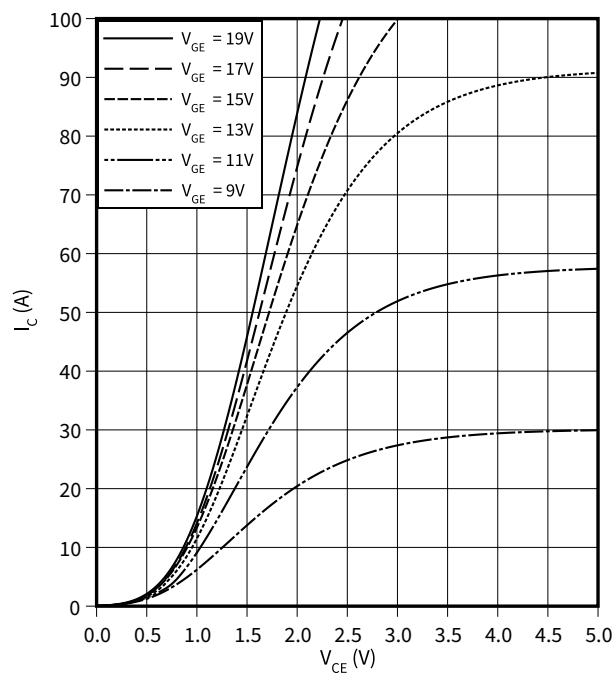
$$V_{GE} = 15 \text{ V}$$



出力特性 (Typical), IGBT- インバータ

$$I_C = f(V_{CE})$$

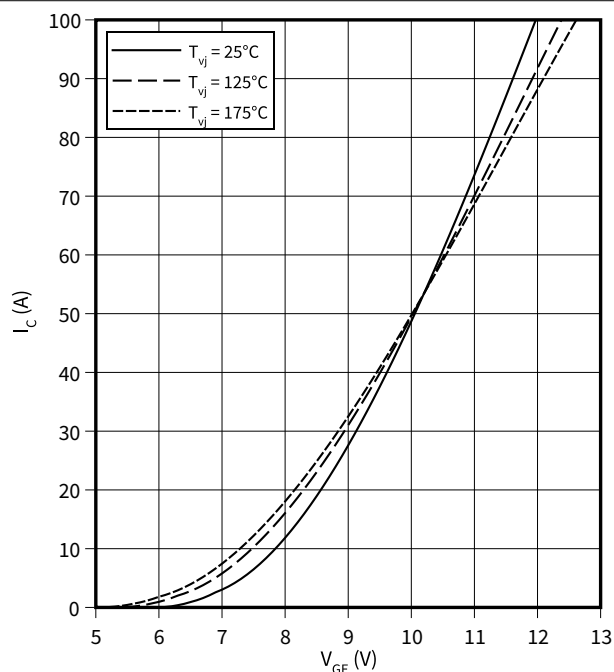
$$T_{vj} = 175 \text{ °C}$$



伝達特性 (Typical), IGBT- インバータ

$$I_C = f(V_{GE})$$

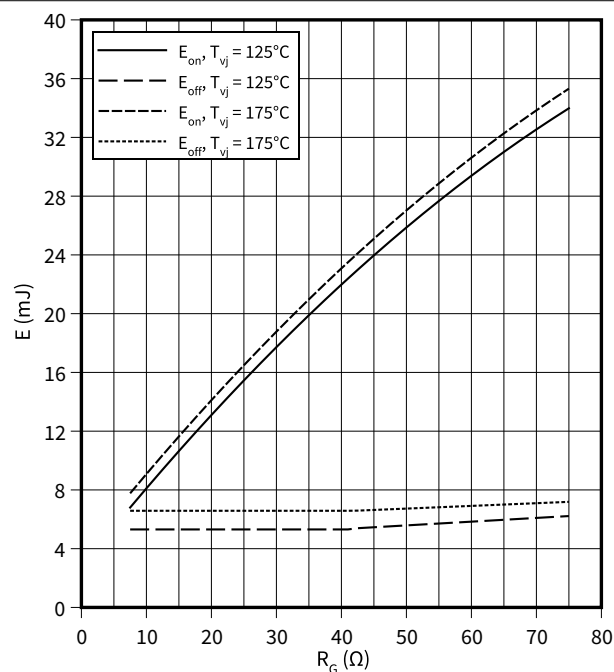
$$V_{CE} = 20 \text{ V}$$



スイッチング損失 (Typical), IGBT- インバータ

$$E = f(R_G)$$

$$I_C = 50 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$$

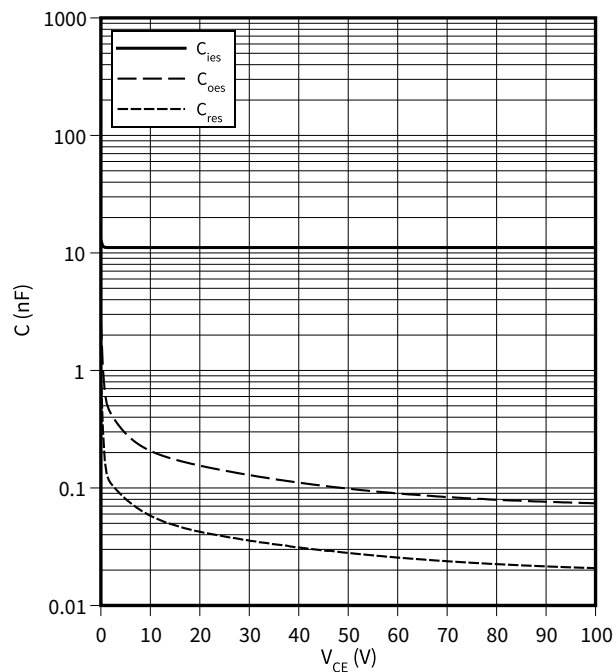


8 特性図

容量特性 (Typical), IGBT- インバータ

$$C = f(V_{CE})$$

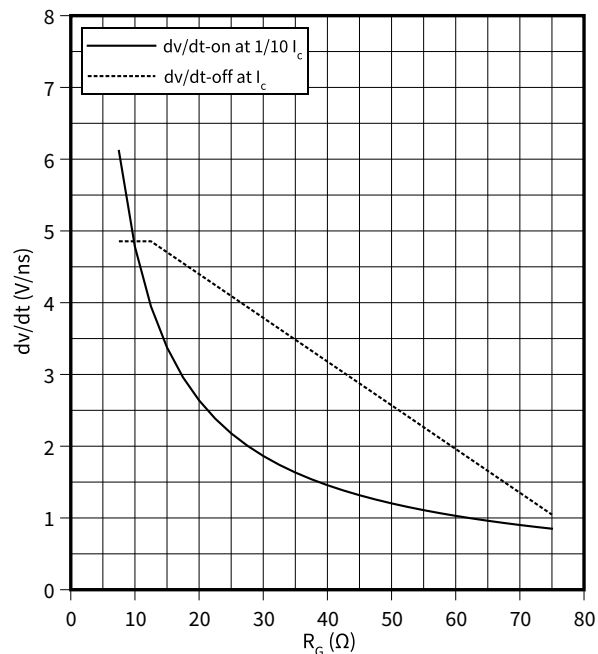
$f = 100 \text{ kHz}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$, $T_{vj} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$



dv/dt (Typical), IGBT- インバータ

$$dv/dt = f(R_G)$$

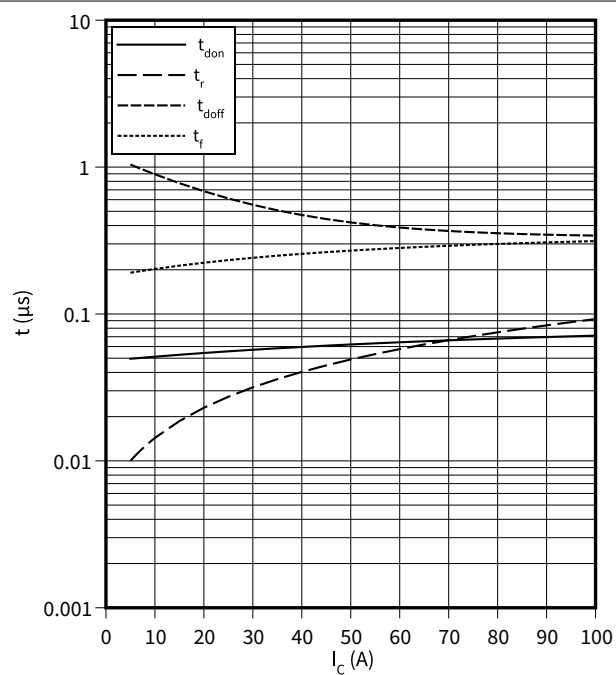
$I_C = 50 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $T_{vj} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$



??? (Typical), IGBT- インバータ

$$t = f(I_C)$$

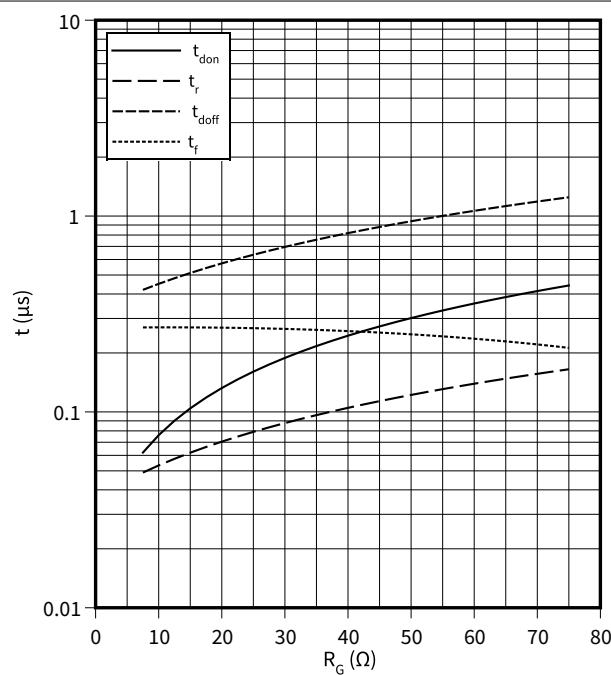
$R_{Goff} = 7.5 \text{ } \Omega$, $R_{Gon} = 7.5 \text{ } \Omega$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $T_{vj} = 175 \text{ }^{\circ}\text{C}$



??? (Typical), IGBT- インバータ

$$t = f(R_G)$$

$I_C = 50 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $T_{vj} = 175 \text{ }^{\circ}\text{C}$

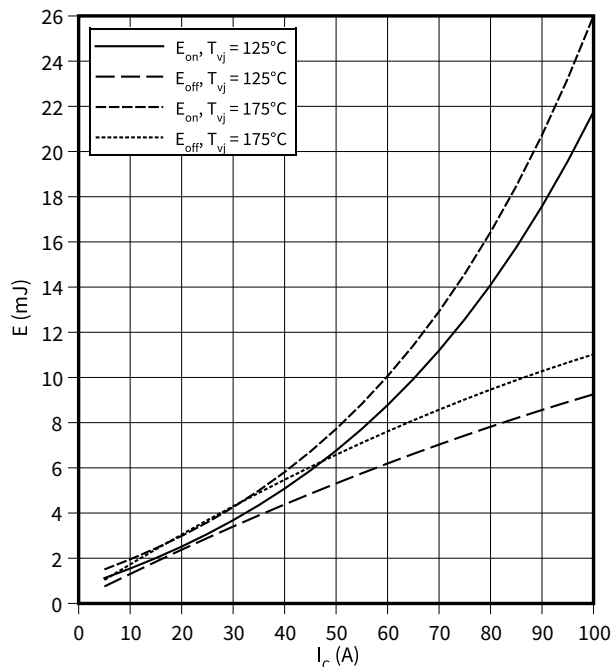


8 特性図

スイッチング損失 (Typical), IGBT- インバータ

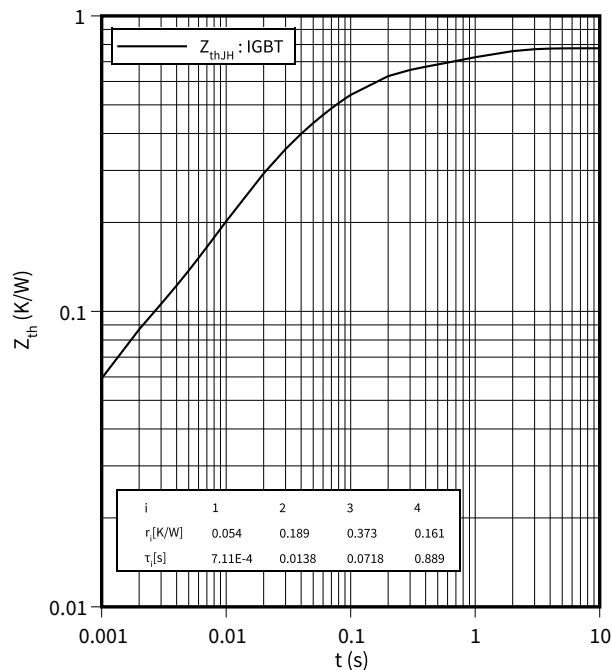
$$E = f(I_C)$$

$R_{Goff} = 7.5 \Omega$, $R_{Gon} = 7.5 \Omega$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$



過渡熱インピーダンス, IGBT- インバータ

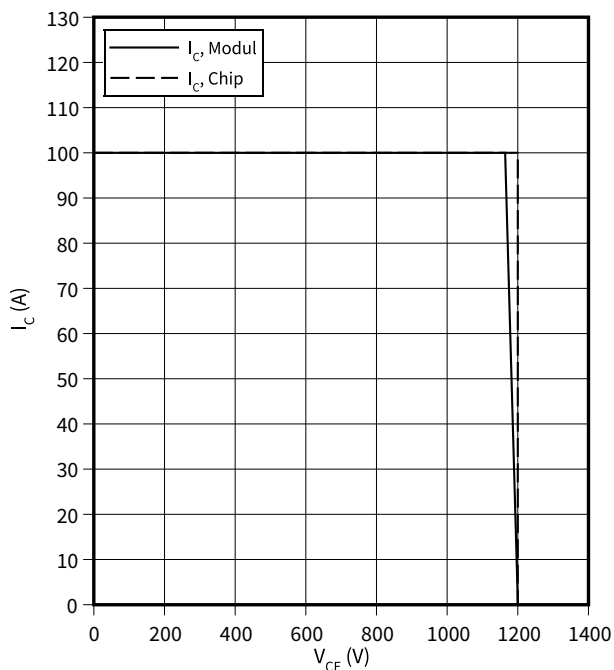
$$Z_{th} = f(t)$$



逆バイアス安全動作領域 (RBSOA), IGBT- インバータ

$$I_C = f(V_{CE})$$

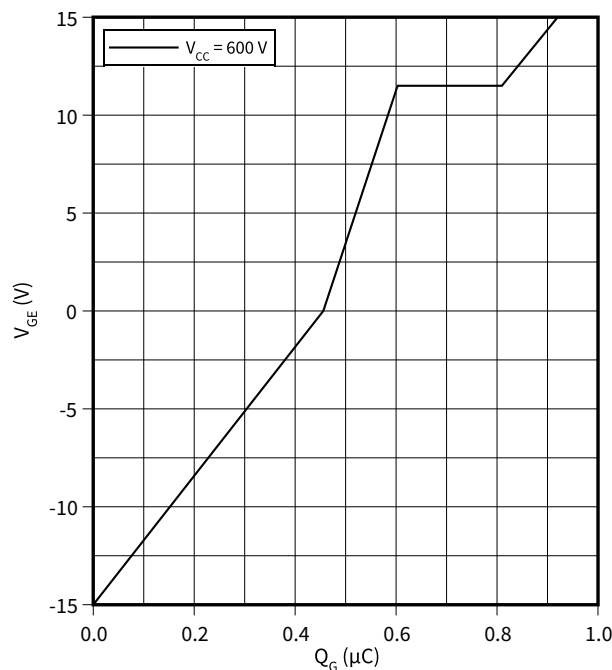
$R_{Goff} = 7.5 \Omega$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $T_{vj} = 175^\circ \text{C}$



ゲート充電特性 (典型), IGBT- インバータ

$$V_{GE} = f(Q_G)$$

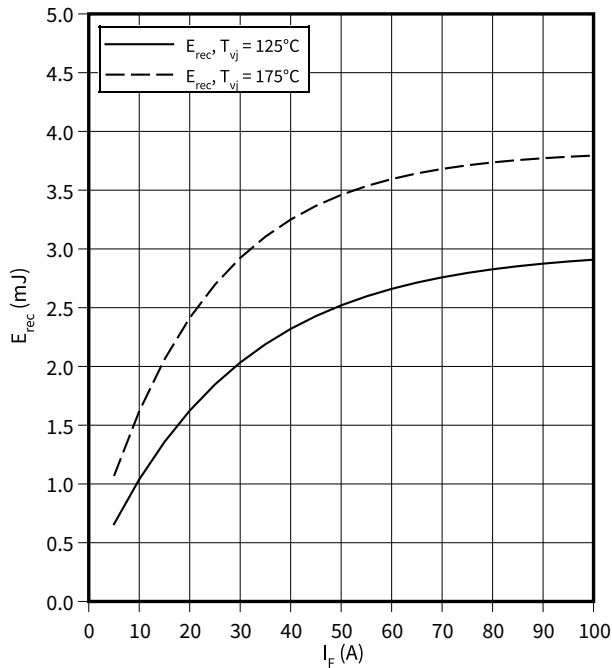
$I_C = 50 \text{ A}$, $T_{vj} = 25^\circ \text{C}$



8 特性図

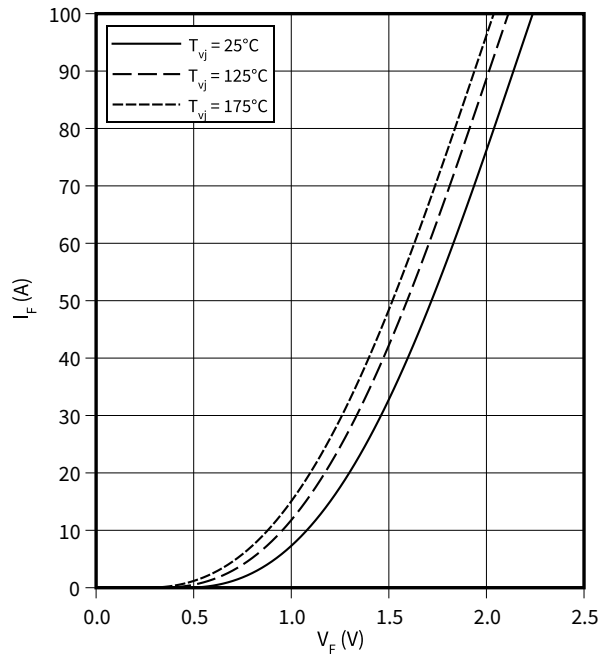
スイッチング損失 (Typical), Diode、インバータ

$E_{rec} = f(I_F)$
 $R_{Gon} = 7.5 \Omega, V_{CE} = 600 V$



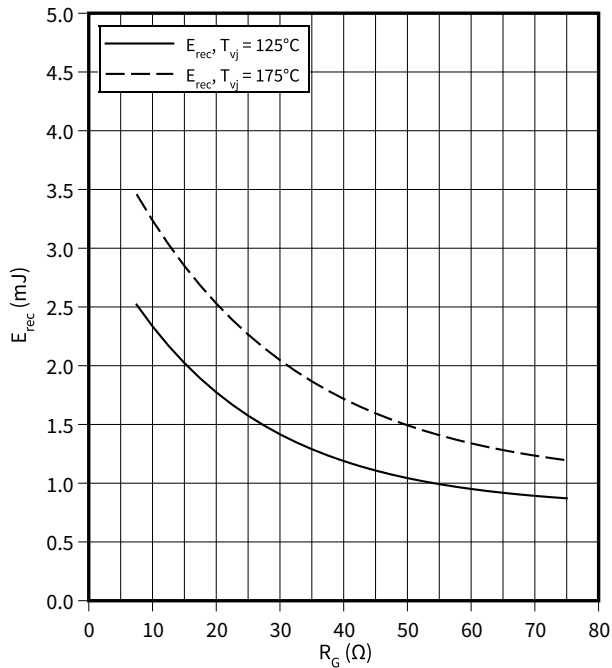
順電圧特性 (typical), Diode、インバータ

$I_F = f(V_F)$



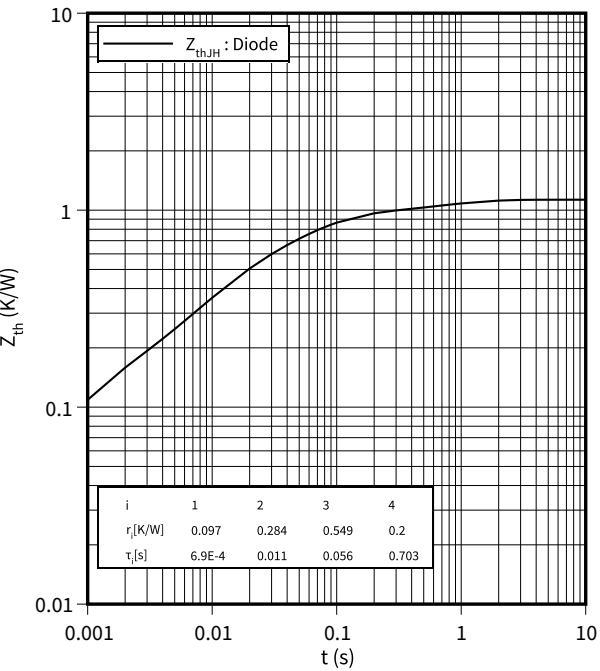
スイッチング損失 (Typical), Diode、インバータ

$E_{rec} = f(R_G)$
 $V_{CE} = 600 V, I_F = 50 A$



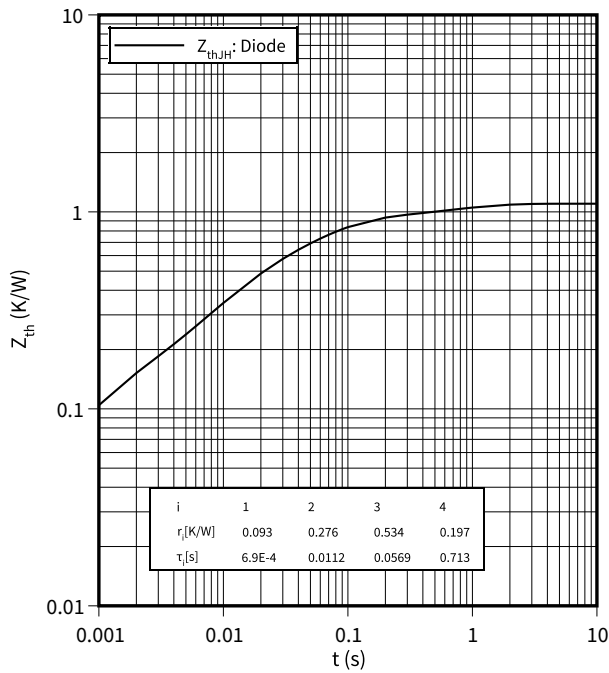
過渡熱インピーダンス, Diode、インバータ

$Z_{th} = f(t)$



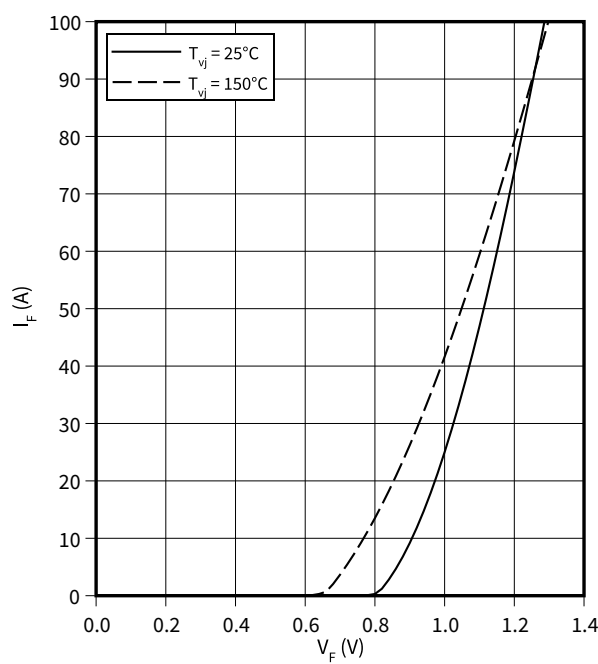
過渡熱インピーダンス, Diode、整流器

$Z_{th} = f(t)$



順方向特性 (典型), Diode、整流器

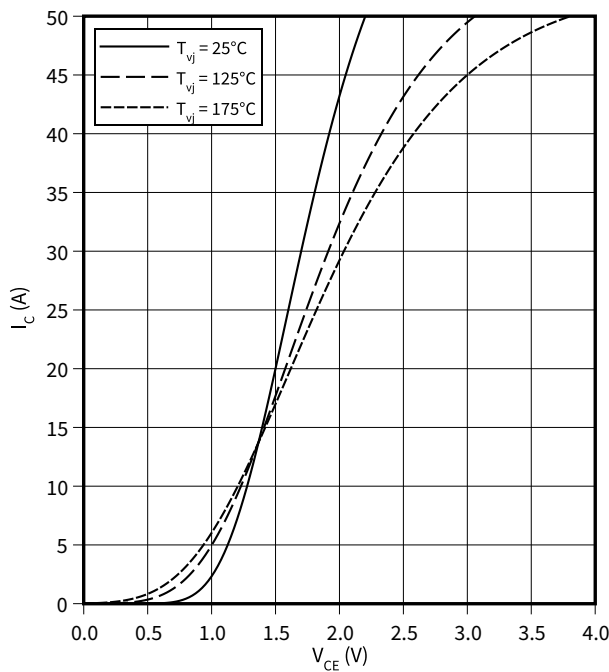
$I_F = f(V_F)$



出力特性 (Typical), IGBT、チョッパ

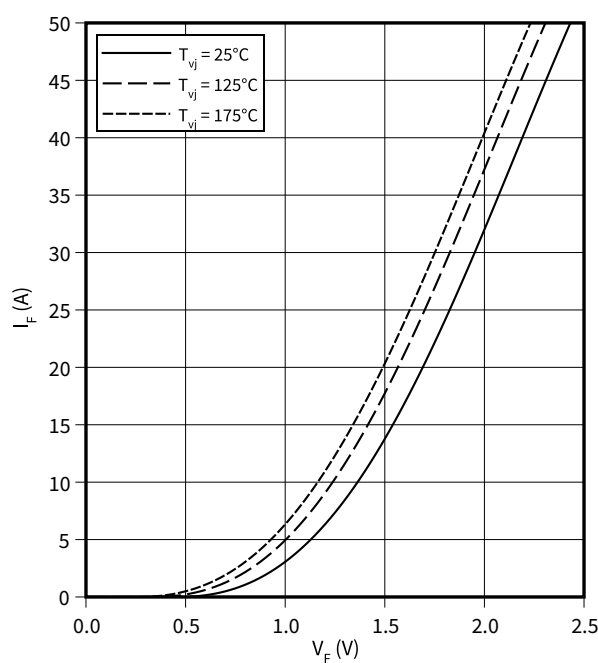
$I_C = f(V_{CE})$

$V_{GE} = 15\text{ V}$



順電圧特性 (typical), Diode-、チョッパ

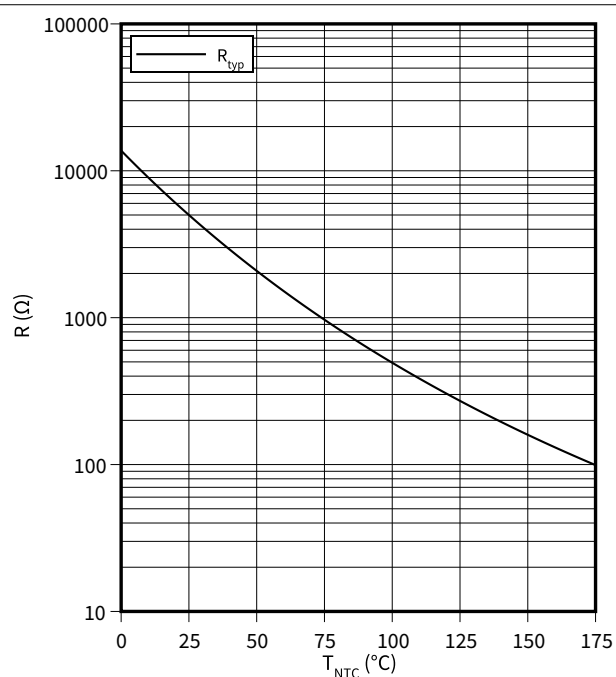
$I_F = f(V_F)$



8 特性図

サーミスタの温度特性, NTC-サーミスタ

$$R = f(T_{NTC})$$



9 回路図

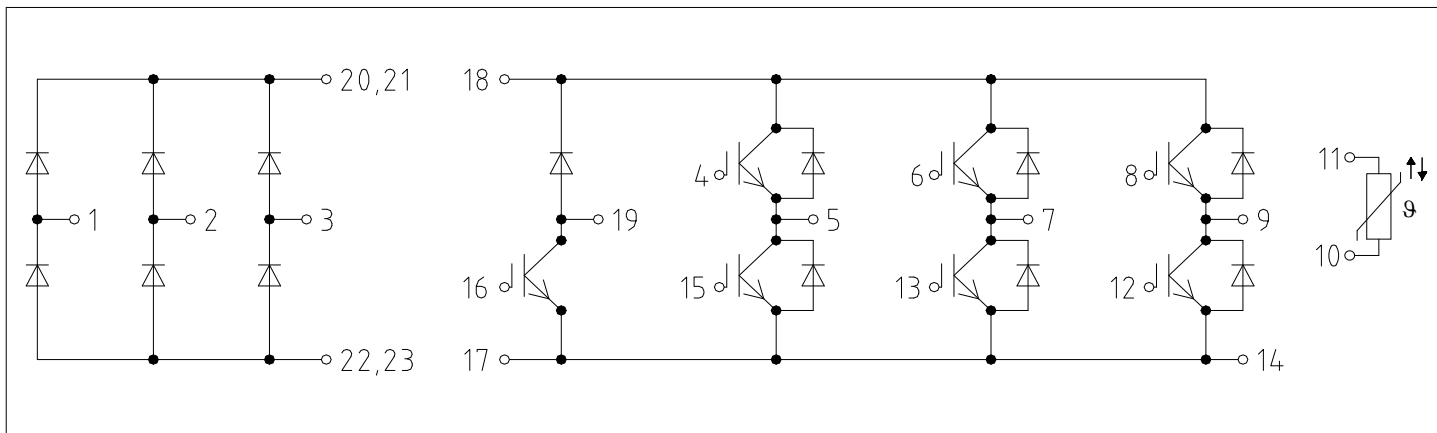


図 2

10 パッケージ外形図

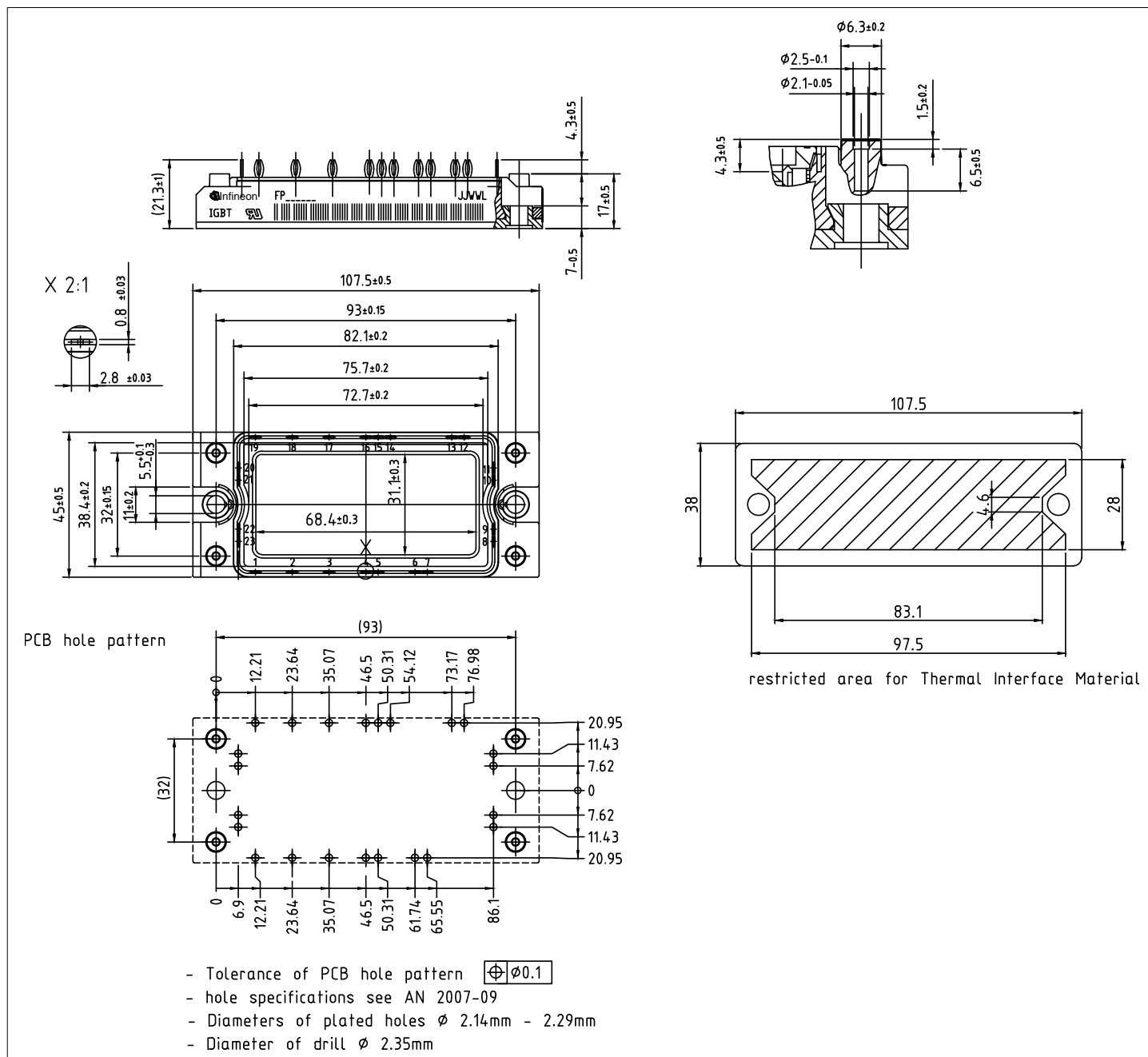


図 3

改訂履歴

改訂履歴

文書改訂	発行日	変更内容
1.00	2021-09-22	Initial version

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2021-09-22

Published by

Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany

© 2021 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABB324-001

重要事項

本文書に記載された情報は、いかなる場合も、条件 または特性の保証とみなされるものではありません（「品質の保証」）。

本文に記された一切の事例、手引き、もしくは一般 的価値、および／または本製品の用途に関する一切 の情報に関し、インフィニオンテクノロジーズ（以 下、「インフィニオン」）はここに、第三者の知的所 有権の不侵害の保証を含むがこれに限らず、あらゆる種類の一切の保証および責任を否定いたします。

さらに、本文書に記載された一切の情報は、お客様 の用途におけるお客様の製品およびインフィニオン製品 の一切の使用に関し、本文書に記載された義 務ならびに一切の関連する法的要件、規範、および 基準をお客様が遵守することを条件としています。

本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受けた従 業員のみを対象としています。本製品の対象用途 への適合性、およびこれら用途に関連して本文書に 記載された製品情報の完全性についての評価は、お 客様の技術部門の責任にて実施してください。

警告事項

技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれる 可能性があります。当該種別の詳細については、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください。

インフィニオンの正式代表者が署名した書面を通じ、インフィニオンによる明示の承認が存在する場合を除き、インフィニオンの製品は、当該製品の障害またはその使用に関する一切の結果が、合理的に 人的傷害を招く恐れのある一切の用途に使用することはできないこと予めご了承ください。